



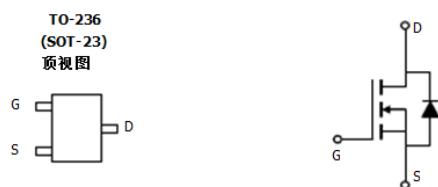
**ALPHA & OMEGA**  
SEMICONDUCTOR, LTD.

启3： 2004年11月

## AO3418, AO3418L (绿色产品)

### N沟道增强型网络场效应晶体管

概述	特点
<p>该AO3418采用先进的沟槽技术提供了优秀的研发 <math>V_{DS(on)}</math>极低的栅极电荷和操作与栅极电压低至2.5V。这装置适合于用作负载开关或以PWM应用程序。AO3418L (绿色产品) 提供的无铅封装。</p>	<p><math>V_{DS} (V) = 30V</math> <math>I_D = 3.8 A</math> <math>R_{DS(on)} \leq 60m\Omega (V_G = 10V)</math> <math>R_{DS(on)} \leq 70m\Omega (V_G = 4.5V)</math> <math>R_{DS(on)} \leq 155m\Omega (V_G = 2.5V)</math></p>



绝对最大额定值牛逼 $A = 25^\circ C$ 除非另有说明			
参数	符号	最大	单位
漏源电压	$V_{DS}$	30	V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 12$	V
连续漏极 A	$T_A = 25^\circ C$	3.8	A
当前	$T_A = 70^\circ C$	3.1	
漏电流脉冲 B	$I_{DM}$	15	
功耗 A	$T_A = 25^\circ C$	1.4	W
	$T_A = 70^\circ C$	0.9	
结温和存储温度范围	$T_J, T_{Storage}$	-55到150	°C

热特性		符号	典型值	最大	单位
最大结点到环境 A	$t \leq 10s$	$R_{ThA}$	70	90	$^\circ C / W$
最大结点到环境 A	稳态		100	125	$^\circ C / W$
最大结对铅 C	稳态	$R_{ThA}$	63	80	$^\circ C / W$

